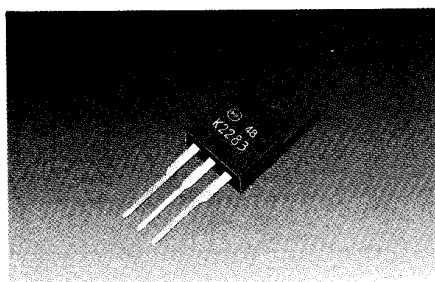


60Vシリーズ パワー-MOSFET 60V SERIES POWER MOSFET

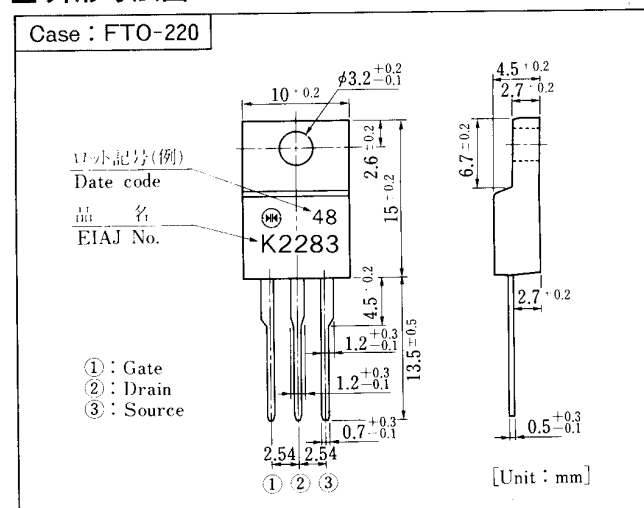
高速スイッチング
N-チャネル、エンハンスメント型

2SK2283 (F10F6N)

60V 10A



外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



■ 定格表 RATINGS

■ 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項 目 Item	記 号 Symbol	条 件 Conditions	規 格 値 Ratings	単 位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
チャネル温度 Channel Temperature	Tch		150	°C
ドレイン・ソース電圧 Drain-Source Voltage	VDSS		60	V
ゲート・ソース電圧 Gate-Source Voltage	VGSS		±20	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	ID	10	A
	Peak	IDP	パルス幅 ≤ 10μs, duty ≤ 1/100 Pulse width ≤ 10μs, Duty cycle ≤ 1/100	A
ソース電流(直流) Continuous Source Current (DC)	IS		10	A
全損失 Total Power Dissipation	PT	Tc=25°C	30	W
単発アバランシェ電流 Single pulse Avalanche Current	IAS	Tc=25°C	10	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	Vdis	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to case, AC 1 minute	2	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値 : 3 kg·cm) (Recommended torque : 3 kg·cm)	5	kg·cm

■ 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (Tc=25°C)

項 目 Item	記 号 Symbol	条 件 Conditions	規 格 値 Ratings			単 位 Unit
			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V(BR)DSS	ID=1mA, VGS=0V	60			V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	IDSS	VDS=60V, VGS=0V			100	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	IGSS	VGS=±20V, VDS=0V			±10	μA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	gfs	ID=5A, VDS=10V	5.0	7.0		S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	RDS(ON)	ID=5A, VGS=10V		0.075	0.1	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	VTH	ID=1mA, VDS=10V	1.0	1.5	2.0	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	VSD	IS=5A, VGS=0V			1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θjc	接合部・ケース間 Junction to case			4.16	°C/W
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics	Qg	VGS=10V, ID=10A, VDD=48V		26		nC
入力容量 Input Capacitance	Ciss	VDS=10V, VGS=0V, f=1MHz		700		pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	Crss			120		
出力容量 Output Capacitance	Coss			310		
ターンオン時間 Turn-on Time	ton	ID=5A, VGS=10V, RL=6Ω		70	140	ns
ターンオフ時間 Turn-off Time	toff			230	480	